








	<p><b>IPI147N12N3GAKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI147N12N3GAKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 120V 56A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  IPI147N12N3GAKSA1.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI147N12N3GAKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 56A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 61µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.7 mOhm @ 56A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3220pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	56A (Ta)

IPI147N12N3GAKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI147N12N3GAKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI147N12N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI147N12N3GAKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI12CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 67A TO262-3</p>	 <p><b>IPI12CN10NG</b> INFINEON IPI12CN10NG INFINEON</p>	 <p><b>IPI16CNE8N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 53A TO262-3</p>	 <p><b>IPI139N08N3G</b> INFINEON IPI139N08N3G INFINEON</p>
 <p><b>IPI12CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO262-3</p>	 <p><b>IPI180N10N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 43A TO262-3</p>	 <p><b>IPI139N08N3GHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A TO262-3</p>	 <p><b>IPI16CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI147N12N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI147N12N3GAKSA1 Datenblatt	IPI147N12N3GAKSA1-Datenblätter	IPI147N12N3GAKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI147N12N3GAKSA1
IPI147N12N3GAKSA1 Electronic	IPI147N12N3GAKSA1-Komponenten	IPI147N12N3GAKSA1-Verteiler	IPI147N12N3GAKSA1-Bild	IPI147N12N3GAKSA1-Teil
IPI147N12N3GAKSA1 Preis	IPI147N12N3GAKSA1 Hersteller	IPI147N12N3GAKSA1 Bild	IPI147N12N3GAKSA1 Aktie	IPI147N12N3GAKSA1 Inventar
IPI147N12N3GAKSA1 Neu	IPI147N12N3GAKSA1 Original	IPI147N12N3GAKSA1 garantiert	IPI147N12N3GAKSA1 RFQ	IPI147N12N3GAKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited